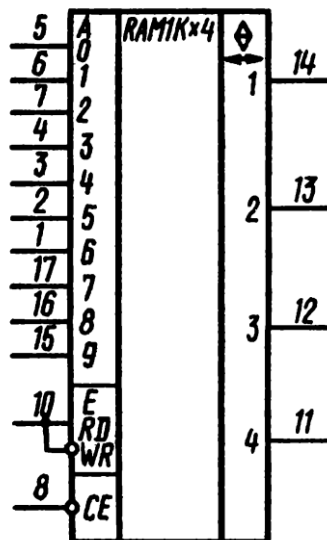


K541PY2, K541PY2A, KP541PY2, KP541PY2A

Микросхемы представляют собой статическое оперативное запоминающее устройство емкостью 4 кбит (1к × 4) с тремя состояниями. Содержат 27 846 интегральных элементов. Корпус типа 427.18-2.03, масса не более 1,6 г и 2107.18-1, масса не более 2,2 г.

Условное графическое обозначение K541PY2, KP541PY2



Назначение выводов: 1 — вход адреса A6; 2 — вход адреса A5; 3 — вход адреса A4; 4 — вход адреса A3; 5 — вход адреса A0; 6 — вход адреса A1; 7 — вход адреса A2; 8 — вход сигнала «выбор микросхемы» \overline{CS} ; 9 — общий; 10 — вход сигнала «запись» \overline{WR} ; 11 — вход/выход информации DI4/DO4; 12 — вход/выход информации DI3/DO3; 13 — вход/выход информации DI2/DO2; 14 — вход/выход информации DI1/DO1; 15 — вход адреса A9; 16 — вход адреса A8; 17 — вход адреса A7; 18 — напряжение питания.

Таблица истинности

Режимы	Вход		Вход/выход
	\overline{CS}	\overline{WR}	DI/DO
Запись	0	0	DI
Хранение	1	X	Z
Считывание	0	1	DO

Примечание: X — произвольное логическое состояние; Z — третье состояние (с высоким выходным сопротивлением).

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания	5 В ± 5%
Выходное напряжение низкого уровня	≤ 0,45 В
Выходное напряжение высокого уровня	≥ 2,4 В
Ток потребления	≤ 100 мА
Входной ток низкого уровня	≤ −0,4 мА
Входной ток высокого уровня	≤ 20 мкА
Ток утечки низкого уровня на выходе	≤ −400 мкА
Ток утечки высокого уровня на выходе	≤ 50 мкА
Время выборки адреса:	
К541РУ2, КР541РУ2	≤ 120 нс
К541РУ2А, КР541РУ2А	≤ 90 нс
КР541РУ2Б	≤ 60 нс
Время выбора	≤ 40 нс
Время сохранения сигнала выходной информации после сигнала выбора	≤ 70 нс
Длительность сигнала записи	≥ 60 нс

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение питания	4,75...5,25 В
Максимальное входное напряжение	5,25 В
Максимальное выходное напряжение	5,25 В
Максимальный выходной ток низкого уровня	8 мА
Максимальный выходной ток высокого уровня	−5,2 мА
Максимальная емкость нагрузки	30 пФ
Максимальное время фронта нарастания (спада) сигнала	10 нс
Температура окружающей среды	−10...+70 °С